



Рис. 8. Зависимость тока стока (I_d) МОП-транзисторов в триодном режиме ($V_d = -0,1$ В и $V_d = -3$ В) от напряжения на затворе (V_g) для контрольных (W/O) и имплантированных (N^+) образцов при обратном порядке БТО ($D_{N^+} = 5 \cdot 10^{13}$ см⁻², $E = 20$ кэВ)

Fig. 8. Dependence of the drain current (I_d) of MOSFETs in the triode mode ($V_d = -0.1$ V and $V_d = -3$ V) on the gate voltage (V_g) for control (W/O) and implanted (N^+) samples with the reverse order of rapid thermal annealing ($D_{N^+} = 5 \cdot 10^{13}$ cm⁻², $E = 20$ keV)